

159НТ101В, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

159НТ101В микросхемы полупроводниковой:

159НТ101В — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в радио-электронной аппаратуре в широком спектре применения с функциональным назначением базовая схема дифференциального усилителя. Микросхемы выполнены в металлостеклянном корпусе. Тип операционного усилителя указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ1 и соответствует техническим условиям для: 2) ХМ3.456.014ТУ.

Ссылки на технические материалы

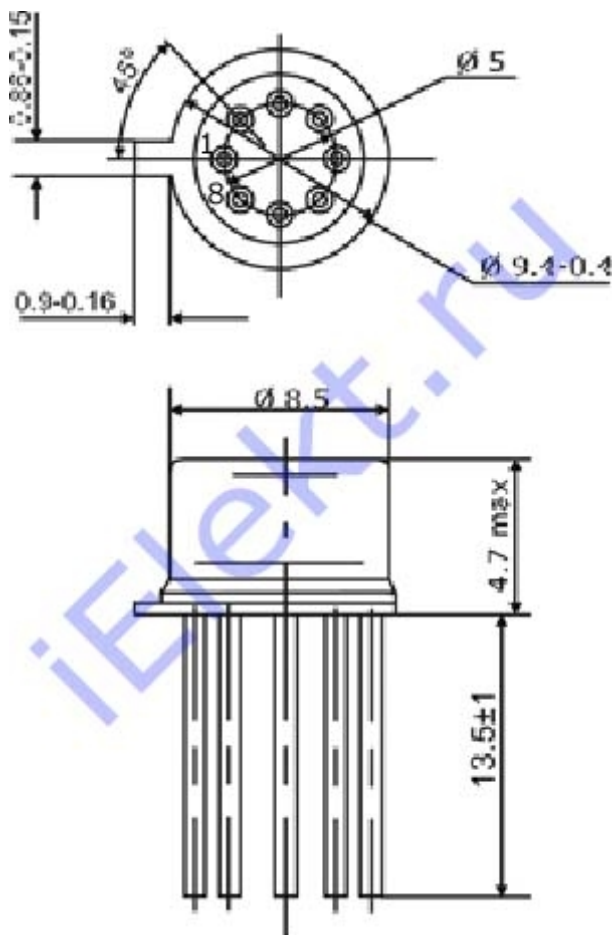
ссылки на 159НТ101В дополнительный материал:

карта	электрическая схема	схема выводов
значение выводов	параметры	параметры в течении 50000 часов
допустимые параметры	PDF	

Знак завода изготовителя

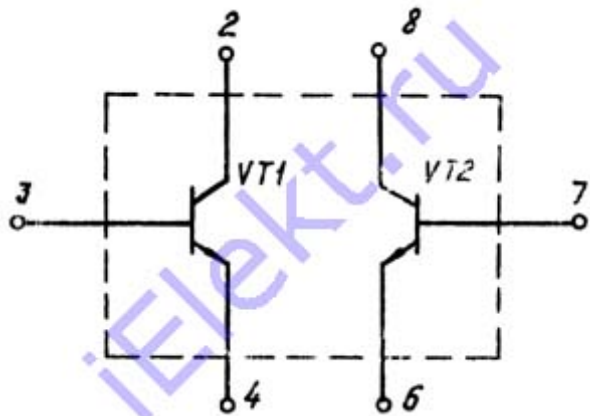


Схема расположения выводов



Вес не превышает: для HT1 1,5g; для HT101 1,4g.
 Длина выводов микросхем: для HT1 20mm; для HT101 13.5mm.

Схема электрическая принципиальная



Назначение выводов

таблица 159HT101B назначение выводов:

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Балансировка	5	Балансировка
2	Вход инвертирующий	6	Выход
3	Вход неинвертирующий	7	Напряжение питания плюс Uип
4	Напряжение питания минус Uип	8	Коррекция

Условия эксплуатации

Микросхемы 159НТ101В допускают эксплуатацию в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок: вибрация в диапазоне частот от 1 до 5000Hz с максимальным ускорением 40g; многократных ударов с максимальным ускорением 150g при длительности удара от 1 до 3ms; одиночных ударов с максимальным ускорением 1000g при длительности удара от 0,2 до 1ms; линейных (центробежных) нагрузок с максимальным ускорением 500g.

Микросхемы допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов: температуры окружающей среды от 213 до 398K; относительная влажность воздуха 98% при температуре 308K без конденсации влаги; смены температуры от 213 до 398K.

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов цельсия

таблица основные 159НТ101В электро параметры:

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Тип микросхемы	Допуск	
Обратный ток коллектора, nA, не более (при $U_{CB}=20V$)	НТ1А-НТ1Е	20	
Обратный ток эмиттера, nA, не более (при $U_{BE}=4V$)	НТ1А-НТ1Е	50	
Начальный ток коллектора, nA, не более (при $U_{CE}=20V$, $R_B=10^4\Omega$)	НТ1А-НТ1Е	50	
Ток утечки между транзисторами, nA, не более (при $U_{TIT2}=25V$)	НТ1А-НТ1Е	10	
Статический коэффициент прямой передачи в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала, в пределах, (при $U_{CB}=5V$, $f=50Hz$, $t_U=2ms$)	IE=1mA	НТ1А, НТ1Г	30-90
		НТ1Б, НТ1Д	60-180
	IE=0,05mA	НТ1Б, НТ1Е	не менее 80
Отношение статических коэффициентов прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала, не менее (при $U_{CB}=5V$, $f=50Hz$, $t_U=2ms$)	IE=1mA	НТ1А, НТ1Б	0,9
		НТ1Г, НТ1Д	0,8
	IE=0,05mA	НТ1В	0,92
		НТ1Е	0,8
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, не менее (при $U_{CB}=5V$, $I_E=3mA$, $f=10^8Hz$)	НТ1А-НТ1Е	2,5	
Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база, mV, не более ($U_{CB}=5V$, $I_E=1mA$)	НТ1А-НТ1В	3,0	
	НТ1Г-НТ1Е	10	
Емкость коллекторного перехода, pF, не более (при $U_{CB}=5V$, $f=10^7Hz$)	НТ1А-НТ1Е	3,0	
Емкость эмиттерного перехода, pF, не более (при $U_{EB}=1V$, $f=10^7Hz$)	НТ1А-НТ1Е	4,0	

Электрические параметры в течение 50000 часов эксплуатации

Параметры 159НТ101В в течении 50000 часов эксплуатации

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Тип микросхемы	Допуск
Начальный ток коллектора, nA, не более	НТ1А-НТ1Е	1,0
Обратный ток эмиттера, nA, не более	НТ1А-НТ1Е	250

Ток утечки между транзисторами, nA, не более		HT1A-HT1E	50
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала, в пределах, не менее	IE=1mA	HT1A, HT1Г	20-100
		HT1Б, HT1Д	40-200
	IE=0,05mA	HT1Б, HT1E	55
Отношение статических коэффициентов прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала, не менее	IE=1mA	HT1A, HT1Б	0,8
		HT1Г, HT1Д	0,7
	IE=0,05mA	HT1В	0,8
		HT1E	0,7
Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база, mV, не более		HT1A- HT1В	5
		HT1Г-HT1E	15

Допустимые режимы эксплуатации

Допустимые 159HT101В режимы

Наименование параметра, режим замера, единица замера	Допустимое значение параметров	Примечание
Максимально допустимое напряжение коллектор-база, V	20	В диапазоне температур от 213 до 398K
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, V	20	
Максимально допустимое напряжение эмиттер-база, V	4	
Максимально допустимое напряжение между транзисторами, V	25	
Максимально допустимый ток коллектора, mA	10	
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, mA	40	
Максимально допустимая мощность рассеивания, mW	75	В диапазоне температур от 213 до 358K

Указания по применению и эксплуатации

Установка и извлечение микросхем 159HT101В из контактирующих устройств при измерениях, ремонте и входном контроле электрических параметров должны производиться при выключении источника питания. При монтаже микросхемы допускается производить изгиб выводов на расстоянии 1-4mm от корпуса микросхемы, радиус изгиба 1+0,5mm.

Пайку выводов допускается производить на расстоянии 1+0,5mm от корпуса микросхемы.

Не рекомендуется использовать микросхему в совмещенных предельных электрических и температурных режимах.

При упаковке, хранении, входном контроле и монтаже микросхем в узлы и блоки аппаратуры, а также при их эксплуатации должны быть приняты меры по защите от статического электричества.

Допустимое значение статического потенциала не более 100V.

Хранение

Микросхемы 159НТ101В следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, вмонтированными в аппаратуру, в комплекте ЗИП при условиях: в отапливаемых (или охлаждаемых) и вентилируемых складах при температуре от 278 до 313К и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 298К.

© [ЭЛЕКТ \(iElekt.ru\)](http://iElekt.ru) - [радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России](#)

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.